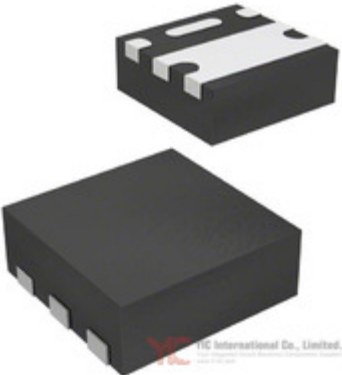

	<p>SIAA00DJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIAA00DJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 25V</p>
	<p>Datenblätter:  SIAA00DJ-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIAA00DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 25V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19.2W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIAA00DJ-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1090pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 20.1A (Ta), 40A (Tc) 3.5W (Ta), 19.2W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.1A (Ta), 40A (Tc)

SIAA00DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIAA00DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIAA00DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIAA00DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA936EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p>	 <p>SIA975DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p>SIA975DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p>SIA972DH-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT-363</p>
 <p>SIA950DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p>	 <p>SIA936EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p>	 <p>SIAERO+-EVB Silicon Labs BOARD EVAL FOR AERO+</p>	 <p>SIA950DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIAA00DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIAA00DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIAA00DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIAA00DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIAA00DJ-T1-GE3
SIAA00DJ-T1-GE3 Vishay			
SIAA00DJ-T1-GE3 Electronic	SIAA00DJ-T1-GE3-Komponenten	SIAA00DJ-T1-GE3-Verteiler	SIAA00DJ-T1-GE3-Bild
SIAA00DJ-T1-GE3 Preis	SIAA00DJ-T1-GE3 Hersteller	SIAA00DJ-T1-GE3 Bild	SIAA00DJ-T1-GE3 Aktie
SIAA00DJ-T1-GE3 Neu	SIAA00DJ-T1-GE3 Original	SIAA00DJ-T1-GE3 garantiert	SIAA00DJ-T1-GE3 RFQ
			SIAA00DJ-T1-GE3 Teil
			SIAA00DJ-T1-GE3 Inventar
			SIAA00DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited